

參考文獻

- [1] R. Bilyalov, C.S. Solanki, J. Poortmans, O.Richad, H. Bender, M. Kummer, H. von Kanel, *Thin Solid Films* 403, 170, 2002.
- [2] P. Vitanov, M. Kamenova, N. Tyutyundzhiev, M. Delibasheva, *Thin Solid Film*, 297, 1997.
- [3] V. Lehmann, “the Physics of Macropore Formation in Low Doped n-Type Silicon,” *J. Electrochem. Soc.*, vol. 140, no. 10, 1993.
- [4] Cullis, A. G. and Canham, L. T., *Nature* 353, 335, 1991.
- [5] G. Smestad, H. Ries, *Solar Energy Materials Solar Cells* 25, 51, 1992.
- [6] McCord, P., Yau, S. L. and Bard., A. J., *Science* 257, 68, 1992.G.
Willeke, H. Nussbaumer, H. Bender, E. Bucher, *Solar Cells* 25, 51,1992.
- [7] V. Torres-Costa, F. Agullo’-Rueda, R.J. Martí’n-Palma, J.M. Martí’nez-Duart, Porous silicon optical devices for sensing applications, *Optical Materials*, 27,1084, 2005
- [8] T. Taliercio, M. Dilhan, E. Massone, A. M. Gue, B. Fraise, A. Foucaran, *Thin Solid Films*255, 310, 1995.
- [9] L. Z. Yu, C. R. Wie, *Electronics Lett.* 28,911, 1992.
- [10] Y. Watanabe, Y. Arita, T. Yokoyama, Y. Igarashi, *J. Electrochem. Soc.*122, p.1351, 197
- [11] J. Mizsei, Gas sensor applications of porous Si layers, *Thin Solid Films*, 515, 8310, 2007.
- [12] A. G. Cullis, L. T. Canham, *Nature* 353, 335, 1991.
- [13] A. Bsiesy, J. C. vial, F. Gaspard, R. Herino, M. Ligeon, F. Muller, R. Romestain, A. Wasiela, A. Halimaoui, G. Bomchil, *Surf. Sci* 254, 195,1991.

- [14] I. Sagnes, A. Halimaoui, G. Vincent, P. A. Badoz, Appl. Phys. Lett. (in press)
- [15] C. Tsai, K.-H. Li, J. Sarathy, S. Shih, J. C. Campbell, Hance, B. K. and White, J. M., Appl. Phys. Lett. 59, 2814, 1991.
- [16] 科學與您 <http://www.c-science.com/txt/tc/te/mp/980402te.htm>
- [17] Art Homa, "Alternative Approaches for DMFC Design: Silicon-Based Systems" 6th Annual SMALL FUEL CELLS(sm), 2004.
- [18] J. L'opez-Garc'ia, R.J. Mart'ın-Palma, M. Manso, J.M.Mart'inez-Duart, Porous silicon based structures for the electrical biosensing of glucose, Sensors and Actuators B, 126, 82, 2007
- [19] nanotechweb.org <http://nanotechweb.org/cws/article/tech/38099>
- [20] 本書為施敏教授與 Kwok K. Ng 博士所撰寫的「半導體元件物理」(Physics of Semiconductor Devices, Wiley)第六版之中譯第一版於 1969 年問世後就陸續被翻譯成 6 種語言。
- [21] C.Pickering, M.J. Beale, D.J. Robbins, P.J. Pearson, and R. Greef, J. Phys. C: Solid State Phys., 17,5535, 1984.
- [22] C.Pickering, M.J. Beale, D.J. Robbins, P.J. Pearson, and R. Greef, J. Phys. C: Solid State Phys., 17,5535(1984)
- [23] M.J. Beale, J.D. Benjamin, M.J. Uren, N.G. Uren, N.G. Chew, and A.G. Cullis, J. Cryst. Growth, 73, 622(1985)
- [24] M.J. Beale, J.D. Benjamin, M.J. Uren, N.G. Uren, N.G. Chew, and A.G. Cullis, Appl. Phys. Lett., 46,86(1985)
- [25] I.M. Young, M.I. Beale and J.D. Benjamin Appl. Phys. Lett., 46(1985)1133

- [26] R.L. Smith, S.F. Chuang, and S.D. Collins, J. Electron. Mater., 17,533(1988)
- [27] R.L. Smith and S.D. Collins, Phys. Rev. A, 39,5409(1989)
- [28] R.L. Smith and S.D. Collins, Phys. J. Appl.Phys., 71, R1(1992)
- [29] T.A. Witten and L.M. Sander Phys. Rev. B, 27, 5686(1983)
- [30] A.J. Read, R.J. Needs, K.J. Naish, L.T. Canham, P.D.J. Calcott, and A. Qteish, Phys, Rev. Lett., 69,1232(1992)
- [31] G.D. Sanders and Y.C. Chang, Phys. Rev. B, 45,856(1992)
- [32] V.Lemann, U.Gösele, Appl. Phys. Lett. 58,856,(1991)
- [33] 鄧伊浚, “電鍍鎳鈷與鎳鐵合金組織與機械性質之研究,” 大葉大學機械工程研究所碩士論文, 2003 年6 月
- [34] 許倍誠, “電鍍鎳組織與機械性質之研究,” 大葉大學機械工程研究所碩士論文, 2000 年2 月
- [35] 阮治鈞, “利用交流電流製備多孔矽結構,” 國立清華大學材料科學工程研究所2006 年7 月
- [36] 陳黼澤, “鎳磷與鈷磷合金電鍍,” 國立台灣大學材料科學與工程學研究所碩士論文, 2005 年7 月
- [37] R.L. Smith and S.D. Collins, Phys. J. Appl.Phys., 71, R1, 1992.
- [38] 陳威綸, “多孔矽材料奈米孔洞之研究與特性分析”, 中國文化大學材料科學與奈米科技研究所, 2006.
- [39] 李力行, 多孔矽與金屬薄膜之加熱性質探討, 中國文化大學材料

科學與奈米科技研究所碩士論文，2007

[40] 陳道達譯，Thermal Analysis，國立編譯館，1992

[41] 沈廉超, 多孔矽材料熱效應之研究與分析，中國文化大學材料科學與奈米科技研究所碩士論文，2008

[42] 黃科智, 超臨界流體沉積技術於多孔矽材料鍍膜表面電特性的影響，中國文化大學材料科學與奈米科技研究所碩士論文，2007

[43] 邱定中, 多孔矽電化學蝕刻法及電鍍法之整合研究，中國文化大學材料科學與奈米科技研究所碩士論文，2007

[44] 吳哲源, 多孔矽之浸泡法後製程之研究，中國文化大學材料科學與奈米科技研究所碩士論文，2007

[44] 方景禮, 電鍍添加劑總論, 表面技術雜誌, 151期(1995)

